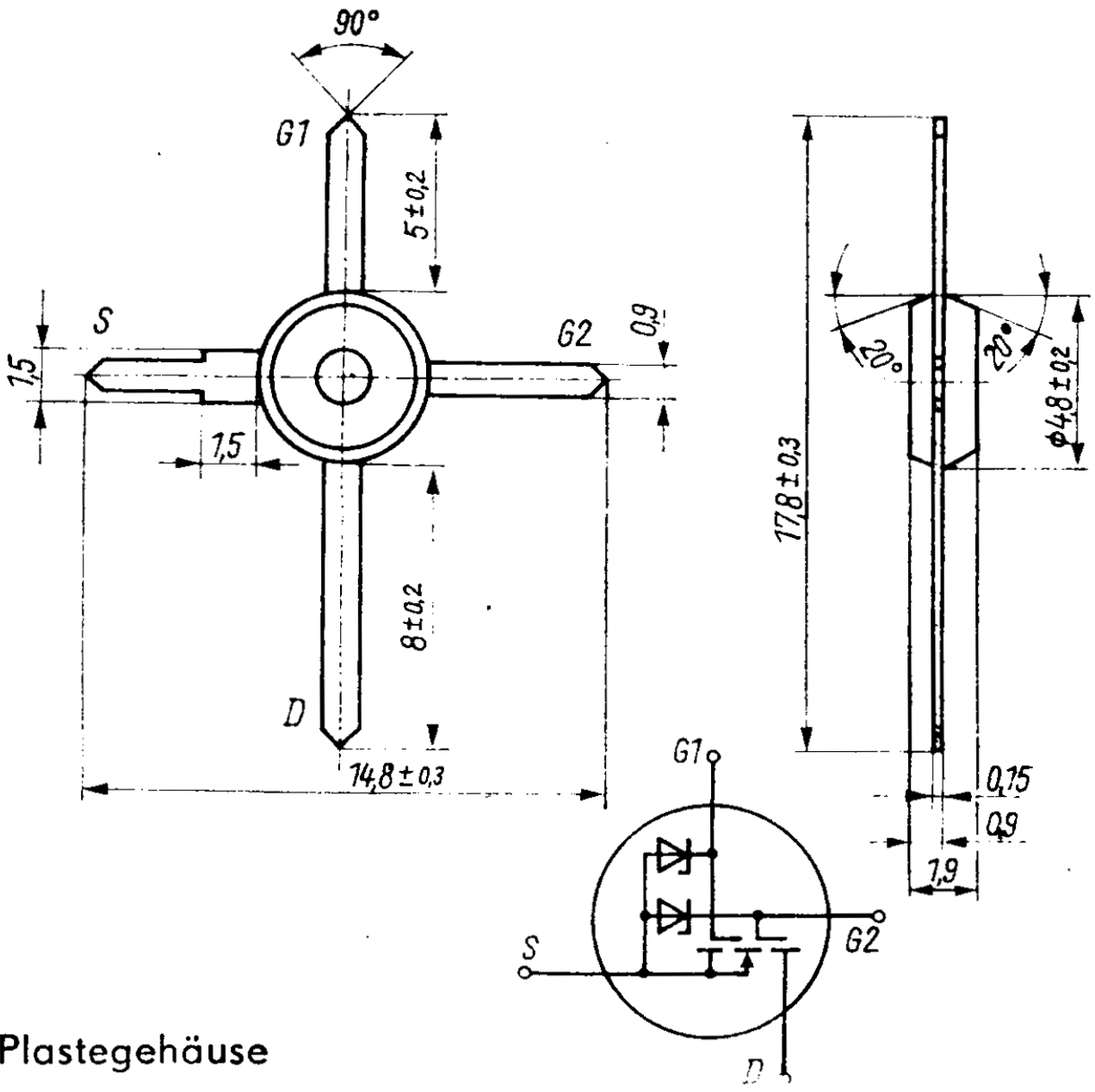


SM 200



Si-MOS-Transistor, bestehend aus jeweils zwei in Kaskade geschalteten MOS-Trioden (n-Kanal-Anreichererstyp) mit integrierten Schutzdioden, vorwiegend für den Einsatz in HF-Verstärkerschaltungen im VHF-Bereich.



Plastegehäuse

Grenzwerte	min	max	
U_{DS}	- 0,3	20	V
U_{G1S}, U_{G2S}	- 0,3	15	V
I_D		30	mA
P_{tot}		300	mW ¹⁾
ϑ_a	0	70	°C
ϑ_{stg}	-55	125	°C

1) bei 25 °C

Statische Kennwerte ($\theta_a = 25^\circ\text{C}$)

	Meßbedingungen	min	typ	max
U_{DS}				15 V
U_{G2S}				15 V
I_{G1SS}	$U_{G1S} = 15\text{ V}, U_{DS} = 0\text{ V},$ $U_{G2S} = 0\text{ V}$			1 μA
I_{G2SS}	$U_{G2S} = 15\text{ V}, U_{G1S} = 0\text{ V},$ $U_{DS} = 0\text{ V}$			1 μA
I_{DSS}	$U_{DS} = 20\text{ V},$ $U_{DG1} = U_{G2S} = 0\text{ V}$			10 μA
$U_{\text{stör}}$	$U_{DS} = 10\text{ V} = U_{G2S},$ $I_D = 15\text{ mA}$	0,25		2,5 V
U_{T2}	$U_{DS} = U_{G2S}, U_{G1S} = 10\text{ V}$ $I_D = 0,01\text{ mA}$	0,25	0,1	2,5 V

Dynamische Kennwerte ($\theta_a = 25^\circ\text{C}$)

S	$U_{DS} = 10\text{ V}, U_{G2S} = 10\text{ V}$ $I_D = 15\text{ mA}$ $f \leq 1\text{ kHz}$	12	18	24 mA
G_p	$U_{DS} = 10\text{ V}, U_{G2S} = 10\text{ V}$ $I_D = 15\text{ mA}$ $f = 2 \cdot 10^8\text{ Hz}$	20		35 dB
ΔG_p	$U_{DS} = 10\text{ V}$ $U_{G2S} = 0\text{ V} \dots 10\text{ V}$ $I_D = 0 \dots 15\text{ mA}^1)$ $f = 2 \cdot 10^8\text{ Hz}$	35		dB
	$U_{DS} = 10\text{ V}, U_{G2S} = 10\text{ V}$ $I_D = 15\text{ mA}$ $f = 2 \cdot 10^8\text{ Hz}$			4,5 dB
C_{11}	$U_{DS} = 10\text{ V}, U_{G2S} = 10\text{ V}$ $I_D = 15\text{ mA}$ $f = 10^6\text{ Hz}$			4 pF
C_{22}	$U_{DS} = 10\text{ V}, f = 10^6\text{ Hz}$ $U_{G1S} = U_{G2S} = 0\text{ V}$		2,5	3 pF
C_{12}	$U_{G2S} = U_{DS} = 10\text{ V}$ $I_D = 15\text{ mA}, f = 10^6\text{ Hz}$		35	50 fF

¹⁾ Maximalwert bei $U_{G2S \text{ max}}$ einstellen